

8a 8g 6
< >
1,31 : 2 :
4 : 6 :
10 : 12 :
14,54 : 18,56 :
20,58 : 22,42 :
24,48,62 : 26,60 :
32 : 34 :
36 : 38 :
40 : 52 :

(Liquid Crystal Display ; LCD)

(Active Matrix)

ated Circuit; , IC (Chip) (Integr
d Bonding) , IC (TAB; Tape Autoamte
TCP(Tape Carrier Package) IC COG(Chips On Glass)
TAB IC TCP

1
1 (2) , IC (4) (6) (GP) (DP)
(2) , (4) 가 가 가 가
(6) (6) / (6,4) (2) (10)
(6) (4) 가 (GP) , (DP)가
(GP) IC IC (2)
(DP) 가 (4)
(GP) (14) (2) 1 (1)
(22) (14) (22) (24) (24) (20)
(20) (16a) (16a) (14) (24)
(22) (18) (2) 3 (1)
(22) (22) (18) (24)
(26) (16b) (18) (24) (26)
ckage ; (GP) (DP) TAB IC가 (Tape Carrier Pa
(20) (26) (14) TCP (24) TAB T
CP (14) (18) (14) (18)가

TCP (20) (26) 4 (28)

(Anisotropic Conductive Film) (12)

(28) TCP (20) (12) (26)

(DP) (DP) TAB IC가 TCP

4) (22) TCP 가 TCP (24) TCP (2)

(24) TCP

(14) (18) (24) (20)

(26) (14) (18)가

(14) (18)

가 가 (24)

[illegible]

(GP) (GP) (32) IC()
 (GP) (GP) IC (TP) (32)
 (58) , (54) (58) IC (42) (48)
) (DP) (34) IC()
 (DP) IC (TP) (34)
 IC (DP) (42) (34) (56) ,
 (48) (60) , (56) (60)
 가 (GP) (DP) 7
 (64) (50a), (50b) (50c) (50b)
 2) (GP) (DP) (48) (GP) (DP) (TP) (6
 (48) (62) (GP) (62) TAB
 (62) (GP) (DP) TCP (58) (60) (Anis
 (48) (48) TAB
 otropic Conductive Film)
 8a 8f 6
 8a (31) (sputtering)
 (Al) (Cu)
 8b (54) (36)
 (42) (54) (36) (31) (42)
 2 (SiOx) (SiNx) (42) 1
 (Chemical Vapor Deposition)
 , 2 N P
 (Dry Etching)
 , 1 2
 (44) (46) (42) CVD (sputteri
 8c , (44) (46) (Cr) (Mo) (56)
 ng) (38) (40) (38) (40) (46) (46)
 (44) (38) (40) (36) (42)
 8d , (56), (38) (40) (31) (42)
 (48) (48) (SiNx)
 (48) (31) (62) (62) (Acryl)
 , BCB(benzocyclobutene), PFCB(perfluorocyclobutane)
 (62) (31) (66)가 (66) (66a),
 (66b) (66c) (66) (66b) (GP)
 (DP) (66a) (66c)
 8e , (31) (66) (66) (62)
 (66a) (66b) (62) (48)
 , (66a) (62) 10~50% 가 (66c)
 8f , (62) (50a), (50b) (50c) (42) (48)
 (62) (48) (62)
 (50a), (50b) (50c) (TP) (50a), (50b) (66)
 (66c)
 (50c) (66) (66b)
 8g , (62) (48) (sputtering)
 ide : IZO) - - - (Indium - Tin - Oxide : ITO), - - - (Indium - Zinc - Ox
 (Indium - Tin - Zinc - Oxide : ITZO)

(60) (48) (42) (56) (48) (50a) (52) (40) (50a) (50c) (52), (62) (58) (62) (58) (54) (60) . . .

• , TAB

가

TAB

TCP

, TC

P

(57)

1.

[illegible]

가

•
;

가
;

가

2.

1 ,

,

3.

1 ,

4.

1 ,

5.

1 ,

6.

5 ,

7.

•
•

•
•

•
•

•
•

가

•
;

가
가

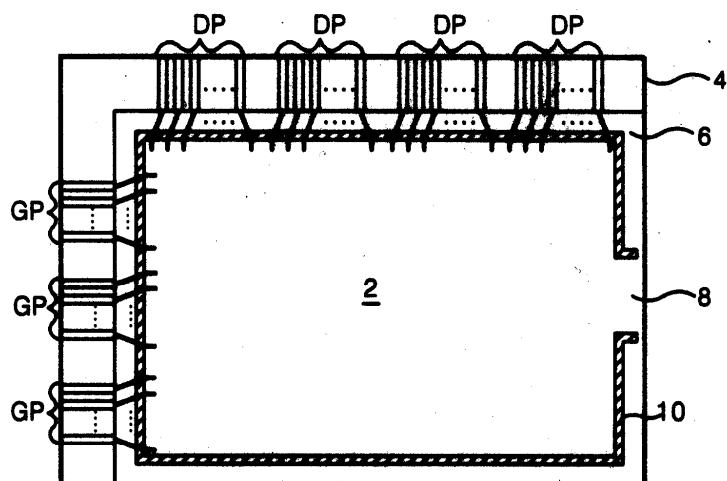
8.

7

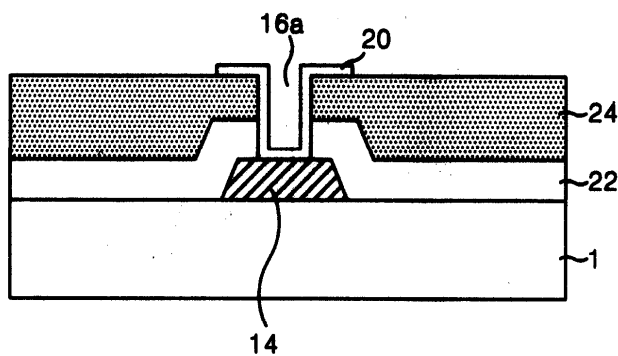
9.

7

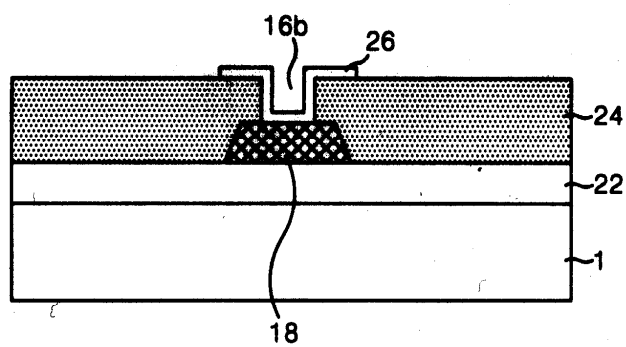
1



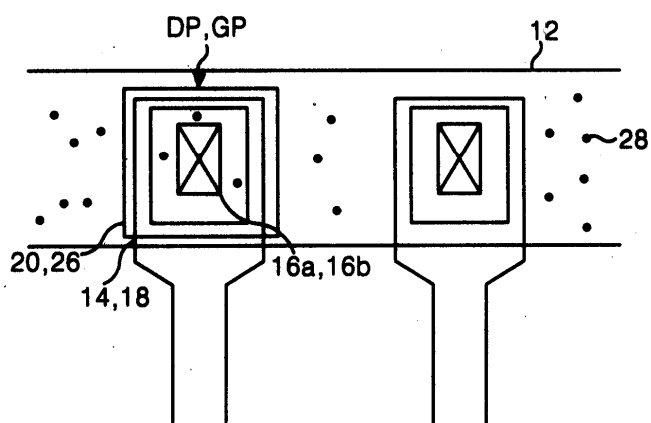
2



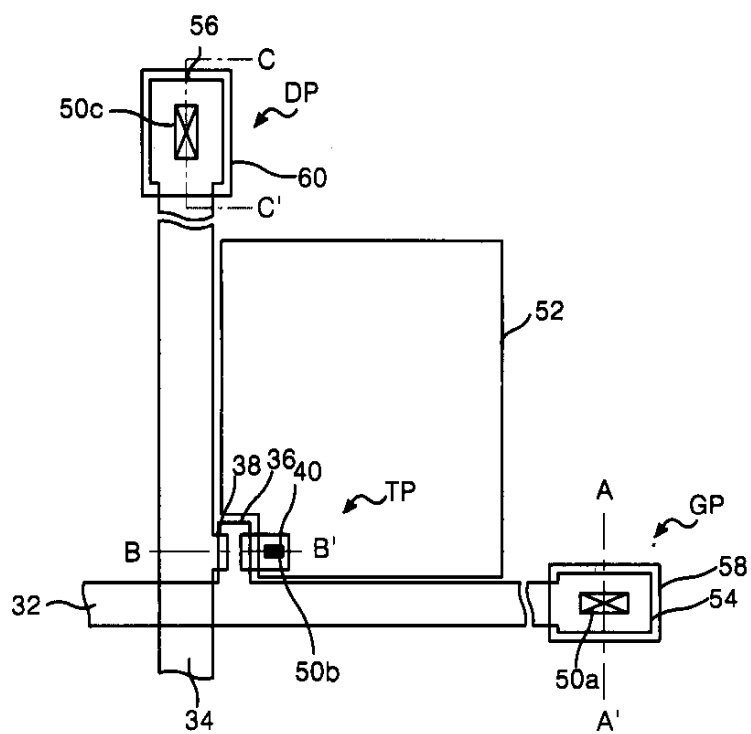
3



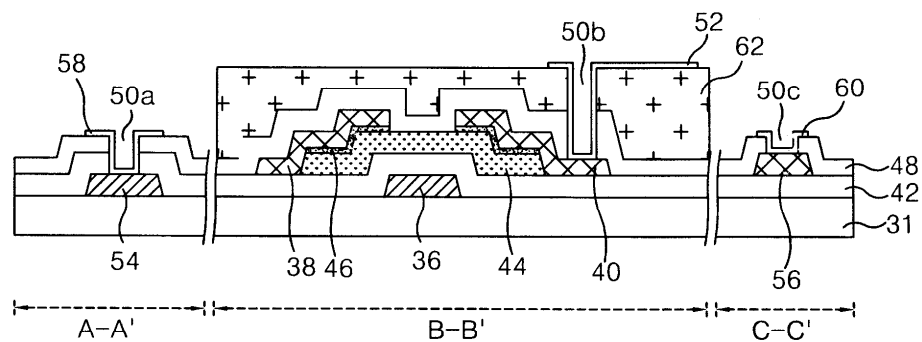
4



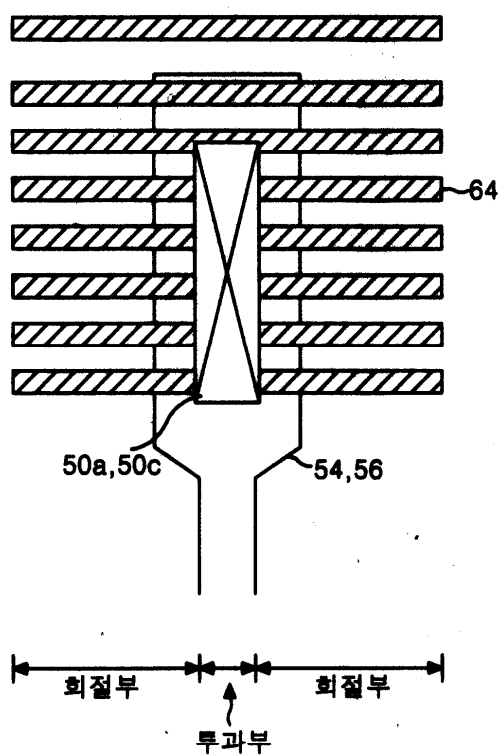
5



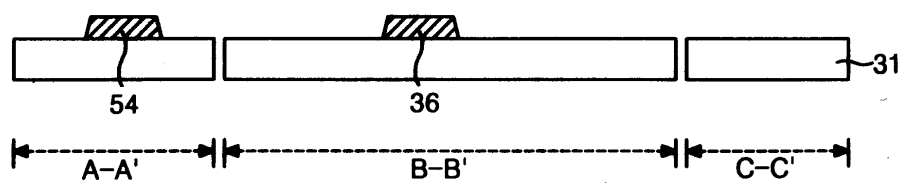
6



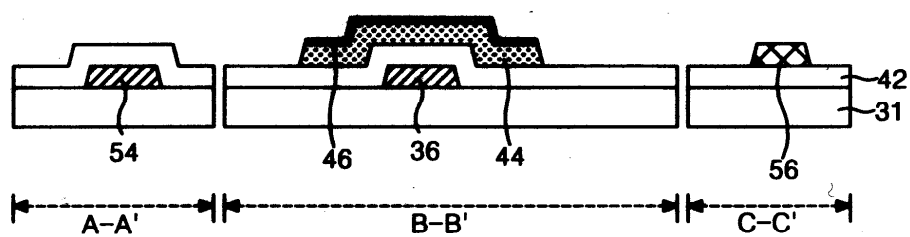
7



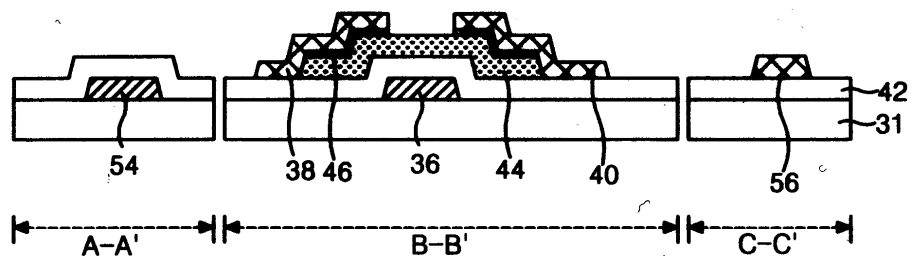
8a



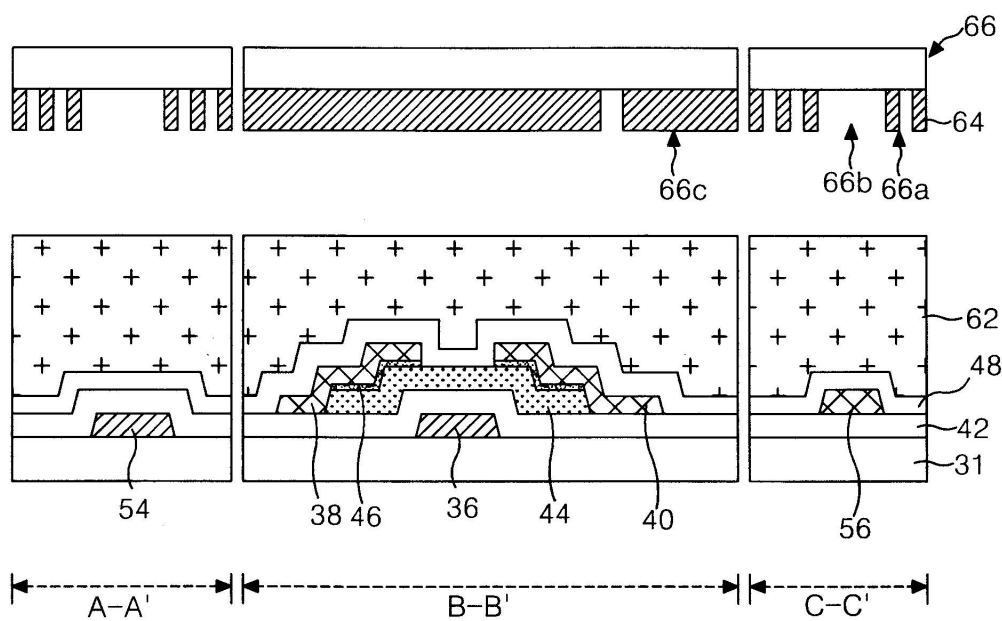
8b



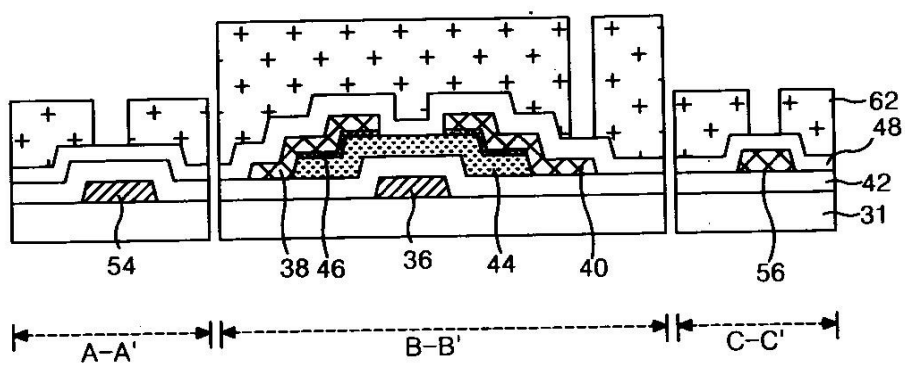
8c



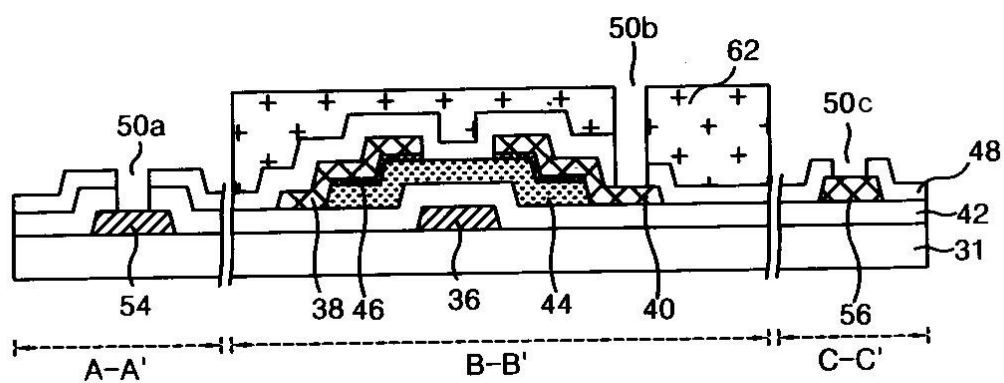
8d



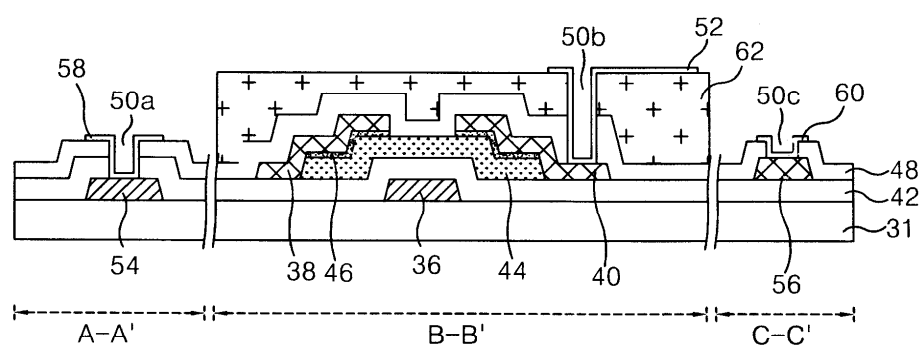
8e



8f



8g



专利名称(译)	液晶显示元件的制造方法		
公开(公告)号	KR100443831B1	公开(公告)日	2004-08-09
申请号	KR1020010081774	申请日	2001-12-20
[标]申请(专利权)人(译)	乐金显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
[标]发明人	SONG INDUK		
发明人	SONG,INDUK		
IPC分类号	G02F1/1362 G02F1/1345		
CPC分类号	H01L27/1214 G02F2001/136236 H01L27/1288 G02F1/13458 G02F1/136227 H01L27/124 H01L27/1248		
代理人(译)	KIM , YOUNG HO		
其他公开文献	KR1020030050984A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

制造液晶显示元件的方法本发明涉及一种能够提高产量的液晶显示元件的制造方法。根据本发明的制造液晶显示装置的方法包括：在基板上形成栅电极和栅极焊盘；在基板上形成栅极绝缘膜；在栅极绝缘膜上形成半导体层；在栅极绝缘膜上形成源电极，漏电极和数据焊盘；在栅极绝缘膜上形成无机保护膜；在无机保护膜上形成有机保护膜；暴露在栅极焊盘的无机保护膜和所述电极焊盘和所述漏电极且包括数据焊盘，在所述电极焊盘的周边部的有机保护膜的部分进行曝光，显影，以留下所述有机保护膜和；使用显影的有机保护膜作为掩模来图案化无机保护膜和栅极绝缘膜，以形成漏极接触孔，栅极接触孔和数据接触孔；以除去一些残存的有机保护膜在所述电极焊盘的外围部分，以暴露无机钝化层以与所述导电膜接触，所述方法包括：形成在所述有机保护膜离开灰化有机钝化层的电极焊盘部分上比焊盘以外的图像显示部分；并在无机保护膜和有机钝化膜上形成透明电极图案。 6

